

### 分科別日程表暫定版

名古屋国際会議場

※この日程表は暫定版ですので、日程、会場が変更になる場合がございます。ご了承ください。

大分類分科名 中分類分科名	2015年9月13日(日)		2015年9月14日(月)		2015年9月15日(火)		2015年9月16日(水)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
<b>1 応用物理学一般</b>								
1.1 応用物理一般・学際領域					2K 10:30 ~ 12:15	PA2 16:00 ~ 18:00		
1.2 教育					PA1 09:30 ~ 11:30			
1.3 新技術・複合新領域						PA3 16:00 ~ 18:00	2K 09:00 ~ 12:15	
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境					PA2 09:30 ~ 11:30	2K 13:45 ~ 17:45		
1.5 計測技術・計測標準		2K 13:45 ~ 16:30		PB3 16:00 ~ 18:00				
1.6 超音波			2K 09:00 ~ 12:15	PB4 16:00 ~ 18:00				
<b>2 放射線</b>								
2.1 放射線物理一般・検出器基礎					2W 09:00 ~ 12:45			
2.2 検出器開発		PA7 18:30 ~ 20:30				2W 13:45 ~ 20:00		2W 13:45 ~ 16:15
2.3 放射線応用・発生装置・新技術							2W 09:00 ~ 12:30	
<b>3 光・フォトニクス</b>								
3.1 光学基礎・光学新領域		2E 13:45 ~ 18:15		PA1 13:30 ~ 15:30				
3.2 材料・機器光学	2A 09:00 ~ 11:45	PA2 16:00 ~ 18:00						
3.3 情報フォトニクス・画像工学		PA3 16:00 ~ 18:00	2E 10:00 ~ 12:00	2E 13:30 ~ 15:15				
3.4 生体・医用光学			PB1 09:30 ~ 11:30	2N 13:45 ~ 18:00				
3.5 レーザー装置・材料	2D 09:00 ~ 12:00	2D 13:45 ~ 16:15	09:00 ~ 12:00	PA2 13:30 ~ 15:30				
CS1 3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション				2G 13:45 ~ 17:15				
3.6 超高速・高強度レーザー	2G 09:45 ~ 12:15	2G 13:45 ~ 17:45	2G 09:30 ~ 12:15	PA3 13:30 ~ 15:30				
3.7 レーザープロセッシング		2F 13:45 ~ 18:15	09:30 ~ 12:00	2F 13:45 ~ 18:00				
				PA12 18:30 ~ 20:30				
3.8 光計測技術・機器					PA3 09:30 ~ 11:30	1E 13:30 ~ 16:30	1E 09:00 ~ 12:00	1E 13:00 ~ 17:00
3.9 テラヘルツ全般			2S 09:00 ~ 12:15	PA7 16:00 ~ 18:00			2J 09:00 ~ 12:15	2J 13:45 ~ 17:00
3.10 光量子物理・技術					4D 09:00 ~ 12:30		PA1 09:30 ~ 11:30	
3.11 フォトニック構造・現象					PA4 09:30 ~ 11:30		2A 09:00 ~ 12:15	2A 13:45 ~ 17:00
CS2 3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 超薄膜・量子ナノ構造のコードシェアセッション						2C 13:45 ~ 20:00		
3.12 ナノ領域光科学・近接場光学					2G 09:15 ~ 12:15	2G 13:45 ~ 18:00	2G 09:15 ~ 12:15	2G 13:45 ~ 16:45
						PA5 18:30 ~ 20:30		
3.13 半導体光デバイス				PA8 16:00 ~ 18:00	1E 09:00 ~ 11:30		2E 10:00 ~ 12:15	2E 13:45 ~ 16:30
3.14 光制御デバイス・光ファイバー			PB2 09:30 ~ 11:30		2F 09:00 ~ 11:45		2F 09:00 ~ 12:15	
CS1 3.5 レーザー装置・材料, 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション				2G 13:45 ~ 17:15				
3.15 シリコンフォトニクス	2S 10:00 ~ 12:15	2S 13:45 ~ 18:00	2N 09:15 ~ 12:15	PA4 13:30 ~ 15:30				
<b>4 JSAP-OSA Joint Symposia 2015</b>								
4.1 Plasmonics	2C 09:00 ~ 12:30	2C 13:45 ~ 17:45	2C 09:00 ~ 12:15					
4.2 Bio- and Medical Photonics							2C 09:15 ~ 12:15	2C 13:45 ~ 17:00
4.3 Optical Micro-sensing, Manipulation, and Fabrications					2C 13:45 ~ 18:00			
4.4 Opto-electronics			PB3 09:30 ~ 11:30		2D 13:45 ~ 19:45			
4.5 Information Photonics						2F 13:45 ~ 19:45		
4.6 Nanocarbon and 2D materials photonics					2D 09:30 ~ 12:15	2D 15:00 ~ 17:45		
4.7 Terahertz Photonics					2E 09:00 ~ 12:45	2E 15:00 ~ 18:45		
<b>6 薄膜・表面</b>								
6.1 強誘電体薄膜			PA1 09:30 ~ 11:30		2L 09:00 ~ 12:15	2L 13:45 ~ 17:15	2L 09:00 ~ 12:00	
6.2 カーボン系薄膜			4F 09:00 ~ 12:00	PA9 16:00 ~ 18:00	4F 09:00 ~ 11:45	4F 13:15 ~ 20:00		
6.3 酸化物エレクトロニクス		2H 13:45 ~ 19:00	2H 09:00 ~ 12:00	2H 13:45 ~ 17:45	2H 09:30 ~ 12:00		2H 09:00 ~ 12:15	
				PA13 18:30 ~ 20:30				
6.4 薄膜新材料	2Q 09:00 ~ 12:15	2Q 13:15 ~ 20:30		PA10 16:00 ~ 18:00	2J 09:00 ~ 11:45			
6.5 表面物理・真空		4E 13:15 ~ 18:45		PA14 18:30 ~ 20:30				
6.6 プローブ顕微鏡				PA11 16:00 ~ 18:00			2U 09:00 ~ 12:15	2U 13:30 ~ 17:00
CS3 6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション					2N 09:30 ~ 11:45			

※この日程表は暫定版ですので、日程、会場が変更になる場合がございます。ご了承ください。

名古屋国際会議場

大分類分科名 中分類分科名 7ビーム応用	2015年9月13日(日)		2015年9月14日(月)		2015年9月15日(火)		2015年9月16日(水)		
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
7.1 X線技術				PB8 18:30 ~ 20:30	4E 10:00 ~ 11:45		4E 09:00 ~ 11:00		
7.2 電子ビーム応用				PB9 18:30 ~ 20:30		4E 13:15 ~ 19:30			
7.3 微細パターン・微細構造形成技術							4E 11:15 ~ 16:45		
7.4 量子ビーム界面構造計測			4E 09:30 ~ 11:15						
7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術	4E 11:00 ~ 11:45			PB10 18:30 ~ 20:30					
7.6 イオンビーム一般				4E 12:30 ~ 18:15 PB11 18:30 ~ 20:30					
<b>8 プラズマエレクトロニクス</b>									
8.0 Plasma Electronics English Session		1F 14:30 ~ 18:45				PB2 18:30 ~ 20:30			
8.1 プラズマ生成・制御						2V 13:00 ~ 19:00			
8.2 プラズマ診断・計測					2V 09:00 ~ 11:30				
8.3 プラズマ成膜・表面処理						PB2 18:30 ~ 20:30	2Q 11:15 ~ 12:15	2Q 13:45 ~ 17:00	
8.4 プラズマエッチング					2Q 09:00 ~ 12:15				
8.5 プラズマナノテクノロジー								2Q 09:00 ~ 11:15	
8.6 プラズマライフサイエンス								2V 09:00 ~ 12:15	2V 13:45 ~ 17:00
8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野						2Q 13:45 ~ 18:15			
8.8 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演		1F 13:00 ~ 14:30	1F 10:30 ~ 11:30			PB2 18:30 ~ 20:30			
8.9 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演			1F 09:30 ~ 10:30						
<b>9 応用物性</b>									
9.1 誘電材料・誘電体		2L 14:00 ~ 17:00	PA2 09:30 ~ 11:30						
9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子			2Q 09:00 ~ 12:30	2Q 14:00 ~ 18:15	PB1 09:30 ~ 11:30				
9.3 ナノエレクトロニクス						PA1 13:30 ~ 15:30	4A 09:15 ~ 11:45		
9.4 熱電変換	2T 09:00 ~ 12:15	2T 14:00 ~ 16:15							
CS4 9.4 熱電変換,16.2 エナジーハーベスティングのコードシェアセッション				PA6 13:30 ~ 15:30					
9.5 新機能材料・新物性	2R 09:00 ~ 12:00	2R 13:45 ~ 16:45		PA5 13:30 ~ 15:30					
<b>10 スピントロニクス・マグネティクス</b>									
10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)	2J 09:00 ~ 12:00	PA1 13:30 ~ 15:30 2J 16:00 ~ 17:45							
10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術				2J 15:00 ~ 18:45	3A 09:00 ~ 11:45				
10.3 GMR・TMR・磁気記録技術		PA1 13:30 ~ 15:30	2J 09:00 ~ 12:15	2J 13:45 ~ 14:45					
10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス							3A 09:00 ~ 11:45	3A 13:45 ~ 17:00	
10.5 磁場応用				4B 13:45 ~ 15:45					
<b>11 超伝導</b>									
11.1 基礎物性	4A 09:45 ~ 12:00	4A 13:00 ~ 17:45							
11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長						4A 13:15 ~ 17:45			
11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用			PA3 09:30 ~ 11:30	4D 13:00 ~ 16:30					
11.4 アナログ応用および関連技術				4A 12:45 ~ 20:00	4A 09:00 ~ 12:00				
11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用					4B 10:00 ~ 11:30	4B 13:00 ~ 14:45			
<b>12 有機分子・バイオエレクトロニクス</b>									
12.1 作製・構造制御			1E 09:00 ~ 11:30	1E 13:00 ~ 18:00	PB2 09:30 ~ 11:30				
12.2 評価・基礎物性				PB5 16:00 ~ 18:00		2N 14:00 ~ 18:30	2N 09:30 ~ 11:30		
CS3 6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション					2N 09:30 ~ 11:45				
12.3 機能材料・萌芽的デバイス	4F 09:00 ~ 11:45	PB8 18:30 ~ 20:30	2A 09:00 ~ 12:15	2A 14:00 ~ 18:30					
12.4 有機EL・トランジスタ	1G 09:00 ~ 11:45	PA4 16:00 ~ 18:00			1G 09:00 ~ 11:45	1G 13:15 ~ 19:00	1G 09:00 ~ 11:45	1G 13:15 ~ 17:00	
12.5 有機太陽電池		2V 15:00 ~ 18:00 PB9 18:30 ~ 20:30	1G 09:00 ~ 11:15		1F 09:30 ~ 12:30	1F 13:30 ~ 17:15			
12.6 ナノバイオテクノロジー		PB4 16:00 ~ 18:00			2A 09:00 ~ 12:00	2A 13:45 ~ 19:45			
12.7 医用工学・バイオチップ	2B 09:00 ~ 12:15	2B 13:45 ~ 15:15			2B 09:00 ~ 12:15	2B 13:45 ~ 18:00			
		PB5 16:00 ~ 18:00							

※この日程表は暫定版ですので、日程、会場が変更になる場合がございます。ご了承ください。

大分類分科名 中分類分科名 13 半導体	2015年9月13日(日)		2015年9月14日(月)		2015年9月15日(火)		2015年9月16日(水)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション						PA4 16:00 ~ 18:00	2D 10:15 ~ 12:15	2D 13:15 ~ 17:00
13.2 探索的材料物性・基礎物性					PB3 09:30 ~ 11:30	2R 13:30 ~ 19:15	2R 09:00 ~ 12:00	
13.3 絶縁膜技術	4C 09:00 ~ 12:15	PA5 16:00 ~ 18:00	4C 09:00 ~ 11:45					
13.4 Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	1C 09:00 ~ 11:45	1C 13:15 ~ 17:15	1C 09:00 ~ 11:45	1C 13:15 ~ 17:30	PB4 09:30 ~ 11:30			
13.5 デバイス/集積化技術			PB4 09:30 ~ 11:30		1C 10:00 ~ 11:45	1C 13:15 ~ 18:00	1C 09:00 ~ 12:00	
13.6 Semiconductor English Session					PB5 09:30 ~ 11:30		2D 09:00 ~ 10:00	
13.7 ナノ構造・量子現象			4D 09:00 ~ 11:45	PB1 13:30 ~ 15:30				
CS2 3.11 フォトニック構造・現象,13.7 超薄膜・量子ナノ構造のコードシェアセッション						2C 13:45 ~ 20:00		
13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術				PB2 13:30 ~ 15:30	4C 09:00 ~ 12:30	4C 14:00 ~ 17:45	4C 09:00 ~ 12:00	4C 13:30 ~ 15:45
13.9 光物性・発光デバイス		PA6 16:00 ~ 18:00	2B 09:30 ~ 12:15	2B 13:45 ~ 16:30			2B 10:00 ~ 12:15	2B 13:45 ~ 16:00
13.10 化合物太陽電池			2M 09:00 ~ 12:15	2M 13:30 ~ 19:15	2M 09:00 ~ 12:15	PB1 13:30 ~ 15:30		
<b>15 結晶工学</b>								
15.1 バルク結晶成長			PB5 09:30 ~ 11:30	2K 13:45 ~ 18:15				
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶	1A 09:00 ~ 11:00	PB1 13:30 ~ 15:30						
15.3 III-V族エピタキシャル結晶		PB2 13:30 ~ 15:30	2W 09:15 ~ 12:15	2W 13:45 ~ 16:30				
15.4 III-V族窒化物結晶	1D 08:45 ~ 11:45	1D 13:15 ~ 20:15	1D 08:45 ~ 11:45	CE 13:00 ~ 14:15	1D 08:45 ~ 11:45		1D 08:45 ~ 12:00	1D 13:15 ~ 17:00
				PB12 18:30 ~ 20:30				
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	2W 09:30 ~ 11:45	2W 13:15 ~ 17:30	PB6 09:30 ~ 11:30					
15.6 IV族系化合物(SiC)				PB6 16:00 ~ 18:00	1A 09:00 ~ 12:00	1A 13:30 ~ 17:30	1A 09:00 ~ 12:00	
15.7 エピタキシーの基礎		PB3 13:30 ~ 15:30		2W 16:45 ~ 18:15				
15.8 結晶評価, 不純物・結晶欠陥		1E 13:15 ~ 18:00		PB7 16:00 ~ 18:00				
<b>16 非晶質・微結晶</b>								
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス					2R 13:45 ~ 18:00			
CS4 9.4 熱電変換,16.2 エナジーハーベスティングのコードシェアセッション			PB7 09:30 ~ 11:30		PA6 13:30 ~ 15:30			
16.3 シリコン系太陽電池					2S 13:45 ~ 17:30	2S 09:00 ~ 12:00	2S 13:30 ~ 17:15	
<b>17 ナノカーボン</b>								
17.1 成長技術			2T 09:00 ~ 12:15	2T 13:45 ~ 17:30		2U 14:00 ~ 16:45	PA2 09:30 ~ 11:30	
			2U 09:00 ~ 12:15					
17.2 構造制御・プロセス				2U 16:45 ~ 18:00			PA2 09:30 ~ 11:30	2T 13:00 ~ 14:45
				2T 17:30 ~ 19:00				
17.3 新機能探索・基礎物性評価		2U 13:45 ~ 16:00				2T 13:45 ~ 18:30	PA2 09:30 ~ 11:30	
17.4 デバイス応用				2U 13:45 ~ 16:45	2T 09:00 ~ 12:15	2U 13:45 ~ 14:00		
<b>21 合同セッションK</b>								
21.1 合同セッションK ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス		PB6 16:00 ~ 18:00	1B 09:00 ~ 12:00		1B 09:00 ~ 11:45	1B 13:15 ~ 18:00	1B 09:00 ~ 12:15	
<b>コードシェアセッション</b>								
CS1 3.5 レーザー装置・材料,3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション				2G 13:45 ~ 17:15				
CS2 3.11 フォトニック構造・現象,13.7 超薄膜・量子ナノ構造のコードシェアセッション						2C 13:45 ~ 20:00		
CS3 6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション					2N 09:30 ~ 11:45			
CS4 9.4 熱電変換,16.2 エナジーハーベスティングのコードシェアセッション				PA6 13:30 ~ 15:30				

※この日程表は暫定版ですので、日程、会場が変更になる場合がございます。ご了承ください。

大分類 中分類 シンポジウム	2015年9月13日(日)		2015年9月14日(月)		2015年9月15日(火)		2015年9月16日(水)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
SP1 人工光合成:材料・物性・デバイスとシステムからのアプローチ						CE 13:15 ~ 18:00		
SP2 ノーベル賞受賞者からの未来へのメッセージ		CE						
SP3 「第6次産業革命」～人と技術の融合による未来産業と社会～								CE
S.13 有機エレクトロニクスの萌芽的研究		1G 13:15 ~ 16:45						
S.14 Ge-CMOSはどこまで進んでいるのか		4C 13:15 ~ 17:00						
S.18 液体シリコンの科学と最新動向		4F 13:15 ~ 17:45						
S.19 機能性原子薄膜化合物材料の応用展開		1A 13:15 ~ 18:15						
S.21 界面ナノ電子化学 「進化する半導体ウェットプロセス ～シリコンから化合物まで～」		1B 13:15 ~ 17:45						
S.22 原子・電子構造制御による次世代デバイス開発に向けた基礎研究と新展開 —多元系化合物ベースの次期太陽電池・新規熱電物質・電子相関物質—		2M 13:15 ~ 18:30						
S.1 企業・地域等が連携したサイエンスコミュニケーション				2L 13:45 ~ 15:45				
S.2 化学分析技術と放射線				2V 13:45 ~ 16:30				
S.3 フォトニクス分科会発足記念シンポジウム「フォトニクスの夢」				1D 13:00 ~ 17:00				
S.5 International Symposium on Thin Film Technologies for Flexible Devices			1A 09:00 ~ 11:45	1A 13:30 ~ 17:00				
S.6 誘電体・強誘電体材料およびデバイスの新展開を求めて				4F 13:30 ~ 17:45				
S.9 プラズマ医療科学の最前線				1F 13:30 ~ 18:00				
S.11 English session: Asian Joint Symposium on Nanobiotechnology		PB7 16:00 ~ 18:00	3A 09:00 ~ 11:45	3A 13:15 ~ 18:30				
S.12 有機無機ペロブスカイト太陽電池の現状と今後の展望			1G 11:15 ~ 12:45	1G 14:00 ~ 18:15				
S.15 越境する絶縁膜/半導体界面技術 ～ Si から Non-Si へ ～				4C 13:30 ~ 16:45				
S.16 窒化物半導体を用いた新機能半導体レーザの創出とその応用 —レーザ発振から20年目を迎えて—				CE 14:15 ~ 17:45				
S.20 酸化物半導体の評価技術				1B 13:15 ~ 18:00				
S.4 量子情報へ向けたシリコンテクノロジーからの挑戦						2M 14:00 ~ 18:30		
S.7 機能性材料・デバイス解析の最近の動向						2H 13:45 ~ 17:00		
S.8 機能性酸化物の原子・ナノスケール機能開拓最前線						2J 13:45 ~ 18:30		
S.10 新規スピントロニクス現象と応用の可能性						3A 13:15 ~ 17:15		
S.17 窒化物半導体特異構造の科学 ～表面・界面の制御と物理～						1D 13:15 ~ 17:45		
<b>2015年度国際フェロー特別講演</b>								
2015年度国際フェロー特別講演		3A 13:30 ~ 16:15						
<b>チュートリアル</b>								
はじめての光学—光の基礎からプラズモニクスまで—		2H 09:00 ~ 12:10						
知的テラヘルツ計測		2M 09:00 ~ 12:10						
超伝導エレクトロニクス—基礎と応用—		2U 09:00 ~ 12:10						
応物参加者のための元特許庁審査官による特許入門 ～特許審査のポイント～		1B 09:00 ~ 12:10						